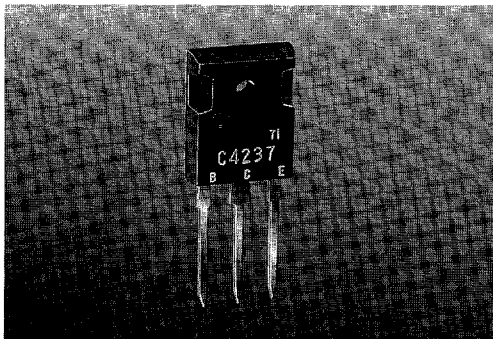
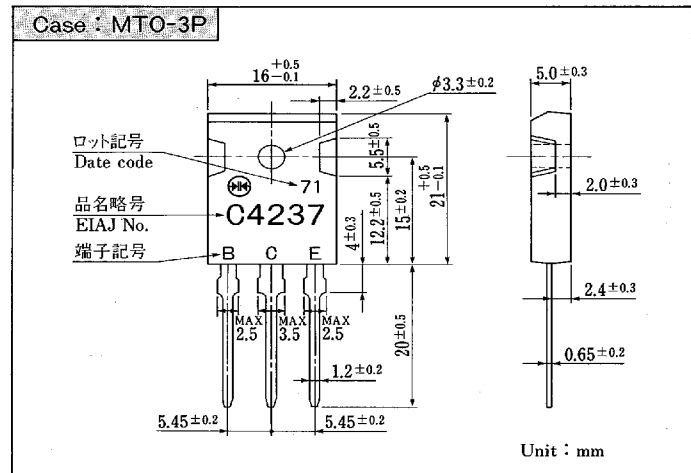


10A
(NPN)

2SC4237
(T10W80HFX)



■外形寸法図 Outline Dimensions



■絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

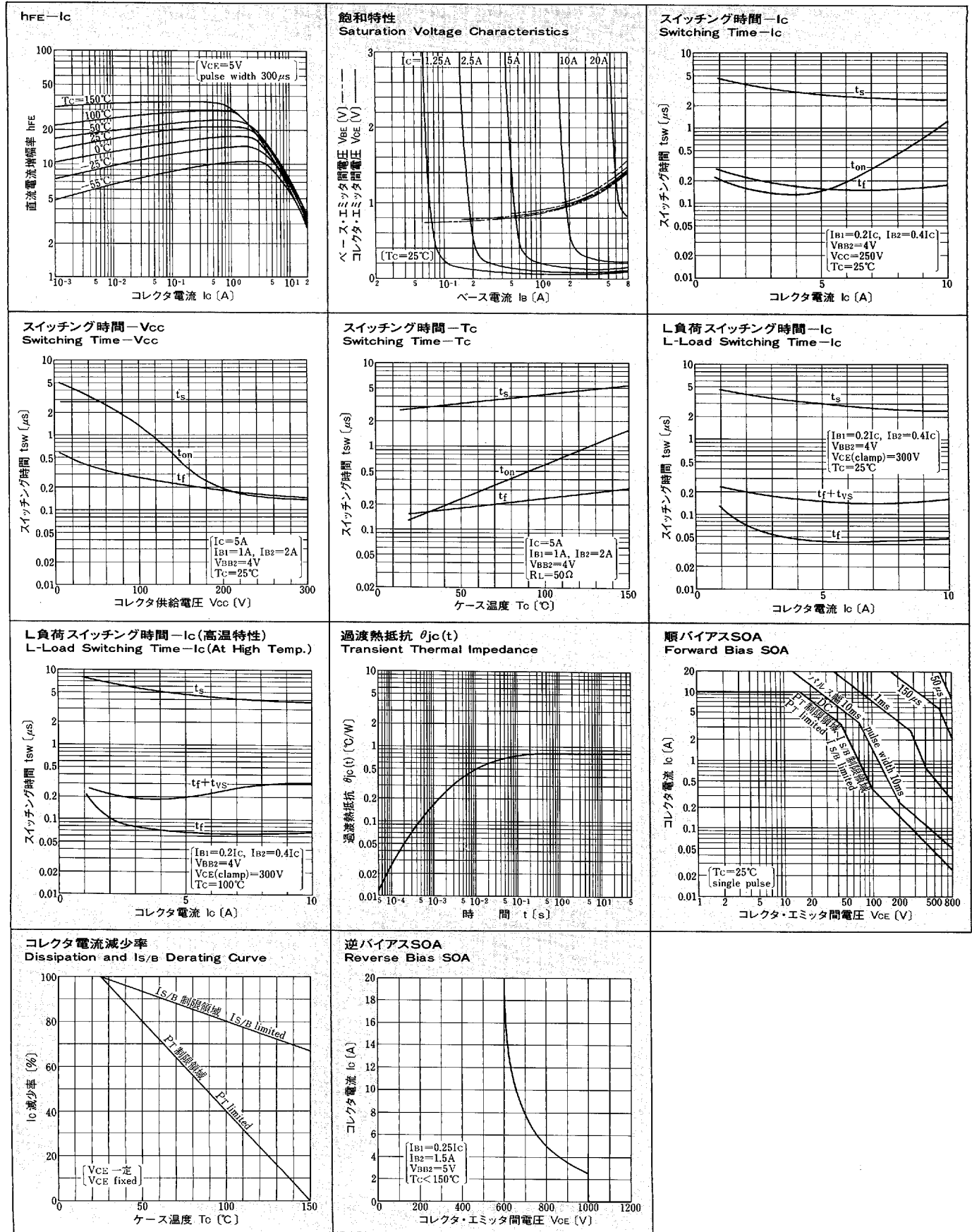
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	°C
接合部温度 Junction Temperature	T _j		150	°C
コレクタ・ベース電圧 Collector to Base Voltage	V _{CB0}		1200	V
コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Voltage	V _{CE0}		800	V
エミッタ・ベース電圧 Emitter to Base Voltage	V _{EB0}		7	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	I _C	10	A
	Peak	I _{CP}	20	
ベース電流 Base Current	DC	I _B	4	A
	Peak	I _{BP}	8	
トランジスタ損失 Total Transistor Dissipation	P _T	T _c =25°C	150	W
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 5kg・cm) (Recommended torque : 5kg・cm)	8	kg・cm

■電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25°C)

コレクタ・エミッタ電圧 Collector to Emitter Sustaining Voltage	V _{CE0(sus)}	I _C =0.2A	MIN 800	V
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I _{CB0}	定格電圧において At rated voltage	MAX 0.1	mA
	I _{CE0}		MAX 0.1	
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	I _{EB0}	定格電圧において At rated voltage	MAX 0.1	mA
直流電流増幅率 DC Current Gain	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =5A	MIN 8	
	h _{FEL}	V _{CE} =5V, I _C =1mA	MIN 5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C =5A, I _B =1A	MAX 1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧 Base to Emitter Saturation Voltage	V _{BE(sat)}		MAX 1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.83	°C/W
トランジション周波数 Transition Frequency	f _T	V _{CE} =10V, I _C =1A	TYP 8	MHz
ターンオン時間 Turn on Time	t _{on}	I _C =5A	MAX 0.5	μs
蓄積時間 Storage Time	t _s	I _{B1} =1A, I _{B2} =2A	MAX 3.5	
下降時間 Fall Time	t _f	R _L =50Ω, V _{BB2} =4V	MAX 0.3	

8219387 0003624 214

■特性図 Characteristics Diagrams



8219387 0003625 150

Shindengen TOKYO, JAPAN